(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 18. Oktober 2001 (18.10.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/78163 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7: 51/20, G03F 7/00

H01L 51/40,

10a, 91074 Herzogenaurach (DE). STÖSSEL, Matthias

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/01444

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. April 2001 (12.04.2001)

(25) Einreichungssprache:

100 18 168.6

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität: 12. April 2000 (12.04.2000)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH & CO. OHG [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regensburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BLÄSSING, Jörg [DE/DE]; Geschwister-Scholl-Strasse 1, 91058 Erlangen (DE). WITTMANN, Georg [DE/DE]; Erlenstrasse [DE/DE]; Äussere Tennenloher Strasse 47, 91058 Erlangen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, US.

(74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Postfach

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

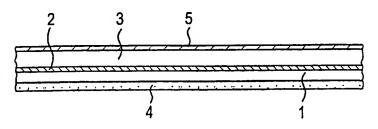
12 10 26, 80034 München (DE).

vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING ORGANIC LIGHT-EMITTING DIODES

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON ORGANISCHEN, LICHT EMITTIERENDEN DIODEN



(57) Abstract: The invention relates to a method for producing organic light-emitting diodes (OLED's) (2.3.5). Whereas in prior art production methods, the color conversion layers (4) were applied in a contactless manner to a substrate (1) using ink jet printing methods, the invention now uses printing methods which directly impinge upon the substrate, namely methods involving

the use of a printing form. Flexographic printing and offset printing, for example, function according to this technique.

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden (OLEDs) (2.3.5) vorgeschlagen. Während bei herkömmlichen Herstellungsverfahren die Farbkonversionsschichten (4) mit Hilfe von Ink-Jet-Durckverfahren berührungslos auf ein Substrat (1) aufgebracht werden, werden nun Druckverfahren verwendet, die das Substrat direkt beaufschlagen, nämlich solche Verfahren, die eine Druckform verwenden. Nach dieser Technik arbeiten beispielsweise der Flexodruck und der Offsetdruck.

1

Beschreibung

Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden

5

25

30

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden (OLEDs), die beispielsweise zur Herstellung von Flachbildschirmen verwendbar sind.

Die Leuchtfähigkeit von Dioden der genannten Art beruht auf der Eigenschaft bestimmter organischer Materialien, bei angelegter Spannung Licht auszusenden. Je nach dem verwendeten Material können so unterschiedliche Farbeffekte erreicht werden. Vielfach werden die aus den genannten Materialien bestehenden Emitterschichten mit einer Farbkonversionsschicht kombiniert. Diese Schichten bestehen aus einem Material, das die von dem Emittermaterial ausgesandten Lichtwellen absorbiert und mit längerer Wellenlänge wieder abstrahlt. Die Farbkonversionsschichten können entweder großflächig oder in Form von Pixeln aufgetragen sein.

Aus der WO 98/28946 ist ein Verfahren bekannt, bei dem Farbkonversionsschichten mit einem von Tintenstrahldruckern her
bekannten Verfahren aufgebracht werden. Die auch als Ink-JetVerfahren bezeichneten Druckverfahren arbeiten berührungslos,
indem das Farbkonversionsmaterial aus feinen Düsen auf die
zu beschichtende Fläche aufgebracht wird. Farbkonversionsschichten sind im Allgemeinen sehr empfindlich gegenüber
Störeinflüssen, etwa wechselnden Schichtdicken oder unebenen
Schichtoberflächen. Mit dem Tintenstrahldruckverfahren lässt
sich aber eine glatte Oberfläche nur sehr schwer erreichen.
Außerdem ist eine exakte Abgrenzung der einzelnen Pixel
gegeneinander schwierig zu bewerkstelligen.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Herstellungsverfahren vorzuschlagen, mit dem sich Farbkonversionsschichten auf technisch einfache, schonende und zuverlässige Weise derart auf-

PCT/DE01/01444 WO 01/78163

2

bringen lassen, dass sie eine gleichmäßige Schichtdicke und eine glatte Oberfläche aufweisen.

Diese Aufgabe wird nach Anspruch 1 dadurch gelöst, dass die 5 Farbkonversionsschicht unter Verwendung einer Druckform auf ein Substrat aufgebracht wird.

Druckverfahren, die eine Druckform verwenden, sind der Flachdruck (z.B. Offsetdruck), der Hochdruck (z.B. Buchdruck und Flexodruck), der Tiefdruck und der Durchdruck. Beim Flach-10 druck liegen die druckenden und die nicht-druckenden Bereiche in einer Ebene, während beim Hochdruck die druckenden Teile erhaben aus der Druckformebene hervorstehen. Beim Tiefdruck sind die druckenden Teile vertieft. Beim Durchdruck, dessen bekanntester Vertreter der Siebdruck ist, ist die Druckform ein sehr feines Maschenwerk. Mit den genannten Druckverfahren lassen sich sowohl großflächige Konversionsschichten als auch solche mit pixelförmiger Rasterung herstellen. Als Substrat dient vorzugsweise ein Glassubstrat oder eine transparente flexible Folie.

Die Erfindung wird nun anhand der Herstellung zweier in den beigefügten Zeichnungen dargestellten Dioden näher erläutert. Es zeigen:

einen schematischen Querschnitt durch eine groß-FIG 1 25 flächige einfarbige Diode und

schematische Draufsichten auf eine Diode, die das FIG 2-4 sukzessive Aufbringen der verschiedenen Schichten darstellen.

30

20

In FIG 1 ist eine einfarbige Diode mit großflächig aufgebrachten funktionellen Schichten dargestellt. Auf die eine Seite eines Glassubstrats 1 ist eine Schicht 2 aus ITO aufgebracht, die als Anode arbeitet. Als Substrat kann auch eine transparente flexible Folie dienen. Auf die ITO-Schicht 2 sind eine oder mehrere funktionelle organische Schichten 3 beispielsweise durch thermisches Verdampfen aufgebracht. Die

WO 01/78163 PCT/DE01/01444

3

funktionellen organischen Schichten 3 sind so gewählt, dass sie blaues Licht emittieren. Auf die organischen Schichten 3 ist Calcium als Kathode 5 abgeschieden. Auf die andere Seite des Glassubstrats 1 ist mit Hilfe eines Offset-Druckverfahrens großflächig eine Farbkonversionsschicht 4 aufgebracht.

10

15

20

25

Bei der in FIG 2-4 dargestellten Diode handelt es sich um einen vergrößerten Ausschnitt einer vollfarbigen Diode. Auf ein Glassubstrat ist zunächst eine Farbkonversionsschicht mit einem der oben genannten Druckverfahren in Form einer Pixelmatrix aufgedruckt. Dabei wechseln sich Pixel 6, 7 mit rot und grün konvertierenden Materialien mit einem freien Platz 8 ab. Die Pixel 6, 7 und der freie Platz 8 bilden zusammen ein übergeordnetes Pixel 9. Die Pixel 6, 7 und der frei bleibende Pixel 8 haben Abmessungen von ca. 80 μ m x 280 μ m. Der Abstand zwischen den Pixeln beträgt ca. 20 μ m. Auf diese Pixelmatrix wird nun großflächig ITO aufgesputtert (= Horizontalschraffur 10 in Fig. 3). Diese Schicht wird photolithographisch zu parallelen Streifen mit einer Breite von ebenfalls 80 um und einem Abstand von 20 μm strukturiert. Als nächster Schritt werden rechtwinklig zu den ITO-Streifen Photolackstreifen 11 mit einer Breite von ca. 30 μ m aufgebracht (Fig. 4). Nun werden die funktionellen organischen Schichten durch thermisches Verdampfen oder durch Aufbringen aus Lösung abgeschieden. Schließlich wird dann noch großflächig eine Kathode aufgedampft.

4

Patentansprüche

- Verfahren zum Herstellen von organischen, Licht emittierenden Dioden, bei dem wenigstens eine Farbkonversionsschicht unter Verwendung einer Druckform auf ein Substrat aufgedruckt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Farbkonversionsschicht auf ein
 Glassubstrat aufgedruckt wird.
 - 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-zeichnet, dass die Farbkonversionsschicht auf eine transparente flexible Folie aufgedruckt wird.

WO 01/78163

PCT/DE01/01444

1/2

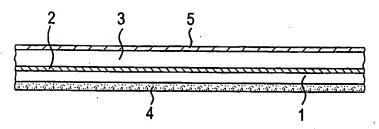


Fig. 1

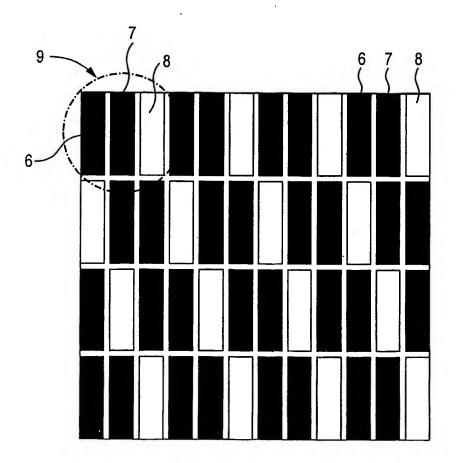
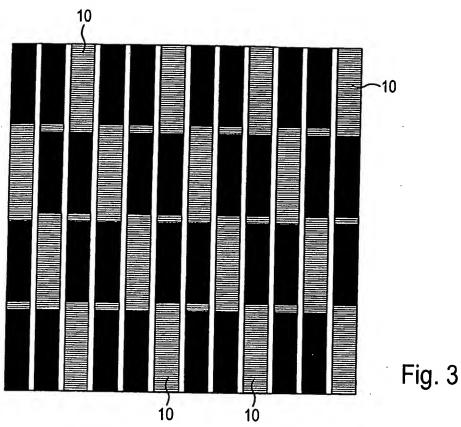
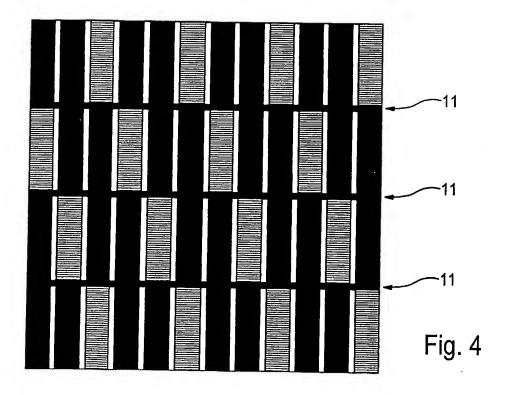


Fig. 2

2/2





THIS PAGE BLANK (USPTO

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ir Ional Application No
PCT/DE 01/01444

			PC1/DE 01/01444
ÎPC 7	SSIFICATION OF SUBJECT MATTER HO1L51/40 HO1L51/20 G03	F7/00	
	g to International Patent Classification (IPC) or to both national	classification and IPC	
	OS SEARCHED		
1PC /			
Document	tation searched other than minimum documentation to the exte	ent that such documents are inclu	ded in the fields searched
	data base consulted during the international search (name of nternal), INSPEC	data base and, where practical,	search terms used)
	notifier, Thories		
C. DOCUM	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category •	Citation of document, with indication, where appropriate, of	the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 884 370 A (TDK CORP) 16 December 1998 (1998-12-16) page 4, line 30 - line 37 page 6, line 51 - line 53		1-3
x	GB 2 333 897 A (FUJI ELECTRIC 4 August 1999 (1999-08-04) page 10, last paragraph	CO LTD)	1,2
P , X	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR 3 January 2001 (2001-01-03) paragraph '0007! - paragraph paragraph '0019! paragraph '0074!		1-3
Furthe	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent tamily me	mbers are listed in annex.
A' documen	egories of cited documents : If defining the general state of the art which is not	"T" later document publish or priority date and no	ed after the international filing date t in conflict with the application but
	red to be of particular relevance cument but published on or after the International te	invention "X" document of particular	e principle or theory underlying the relevance; the claimed invention
which is citation of document	t which may throw doubts on priority claim(s) or cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified) at reterring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular cannot be considered	novel or cannot be considered to tep when the document is taken alone relevance; the claimed invention to involve an inventive step when the d with one or more other such docu-
other me document		ments, such combination the art. *a* document member of the	ion being obvious to a person skilled
ate of the ac	tual completion of the international search		international search report
31	July 2001	08/08/200	1
me and mai	iling address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Agne, M	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ir ional Application No PCT/DE 01/01444

Patent document cited in search report		Publication date	1	Patent family member(s)	Publication date
EP 0884370	A	16-12-1998	JP US	10338872 A 6023371 A	22-12-1998 08-02-2000
GB 2333897	Α	04-08-1999	JР	11219786 A	10-08-1999
EP 1065725	Α	03-01-2001	CN	1279515 A	10-01-2001

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ionales Aktenzeicher PCT/DF 01/01444

		I	, , , , , , , , , , , , , , , ,		
A. KLASS IPK 7	SIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L51/40 H01L51/20 G03F7/(00			
Nach der ir	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen K	Classifikation und der IPK			
	ERCHIERTE GEBIETE				
IPK 7	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssym H01L G03F				
,	erte aber nicht zum Mindestprüfstott gehörende Veröffentlichungen,				
	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (stenna 1 TNSPFC	(Name der Datenbank urk	d evil. verwendete Su	chbegriffe)	
ELO-111	ternal, INSPEC				
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie*	Bezeichnung der Verölfentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommer	nden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
χ .	EP 0 884 370 A (TDK CORP) 16. Dezember 1998 (1998-12-16) Seite 4, Zeile 30 - Zeile 37 Seite 6, Zeile 51 - Zeile 53			1-3	
X	GB 2 333 897 A (FUJI ELECTRIC CO 4. August 1999 (1999-08-04) Seite 10, letzter Absatz	LTD)		1,2	
P,X	EP 1 065 725 A (SEMICONDUCTOR EN 3. Januar 2001 (2001-01-03) Absatz '0007! - Absatz '0015! Absatz '0019! Absatz '0074!	ERGY LAB)		1-3	
Weite entne	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang P	atentfamilie		
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeulsam anzusehen ist am oder nach dem internationalen Anmelded atum veröffentlicht worden ist und mit der Anmelden nicht kollikelt, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Prinzips od					
Datum des At	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des ir	nternationalen Rechei	rchenberichts	
31	. Juli 2001	08/08/20	01		
Name und Po	stanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigler Bed Agne, M	liensteter		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

ir onales Aktenzeichen
PCT/DE 01/01444

im Recherchenberic angeführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung		(litgiled(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0884370	Α	16-12-1998	JP US	10338872 A 6023371 A	22-12-1998 08-02-2000
GB 2333897	Α	04-08-1999	JP	11219786 A	10-08-1999
EP 1065725	A	03-01-2001	CN	1279515 A	10-01-2001